CMP AL,4

Họ và tên:Chấm bài:Điểm:SHSV:SHSV:Điểm chấm lại:

```
Bài 1 (5 điểm)
Viết chương trình assembly thực hiện:
                                                              (1 điểm)
Nhập 2 số a,n từ bàn phím.
Kiểm tra điều kiện 5\(\frac{1}{2}\)a=9, 0\(\frac{1}{2}\)n, dừng nếu không thỏa mãn.
                                                              (2 điểm)
Viết các giá tri a-1, a-2, ..., a-n ra màn hình.
                                                              (2 điểm)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  TB1 DB ,10,13,'Nhap so a :',10,13,'$'
  TB2 DB 10,13,'Nhap so n:',10,13,'$'
  TB3 DB 10,13,'Ket_qua',10,13,'$'
  a DB 0
  n DB 0
  tam db 0
.CODE
MAIN PROC
  MOV AX,@DATA
  MOV DS,AX
Nhap_so_a:
  MOV AH,09H
  LEA DX,TB1
  INT 21h
  MOV AH,01
  INT 21H
  SUB AL,30H
  CMP AL,9
  JA Ket_thuc
                              hoac
                                    JA Nhap_so_a
  CMP AL,5
  JB Ket thuc
                               hoac JB Nhap so a
  MOV a,AL
Nhap_so_n:
  MOV AH,09H
  LEA DX,TB2
  INT 21h
  MOV AH,01
  INT 21H
  SUB AL,30H
```

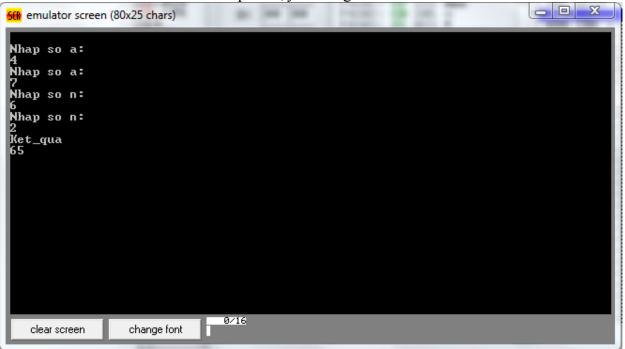
Số 5. Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý JA Ket\_thuc ; hoac JA Nhap\_so\_n CMP AL,0 JB Ket\_thuc ; hoac JB Nhap\_so\_n MOV n,AL XOR CX,CX MOV CL,n MOV tam,1 MOV AH,09H LEA DX,TB3 INT 21h Hien\_thi: XOR DL,DL MOV DL,a SUB DL,tam ADD DL,30h MOV AH ,02h INT 21h INC tam LOOP Hien\_thi Ket\_thuc: MOV AH,4CH

## MAIN ENDP

INT 21H

Kết quả chạy chương trình:

Hạn nộp:10/11/2013



## **Bài 2 (5 điểm)**

Tìm hiểu công nghệ lưu trữ Flash:

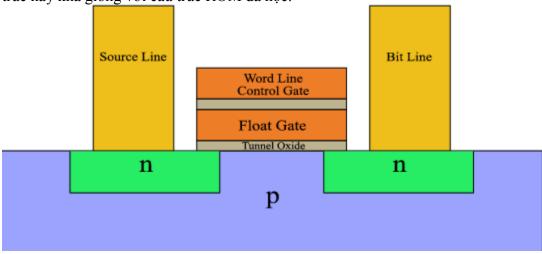
Cấu trúc một phần tử nhớ, (2 điểm) Cách thức lưu trữ, đọc, ghi dữ liệu, (2 điểm) tốc độ truy cập (đọc/ghi), số lần ghi, ... (1 điểm)

Chú ý: có thể có 2 cách thức thiết kế phần tử nhớ.

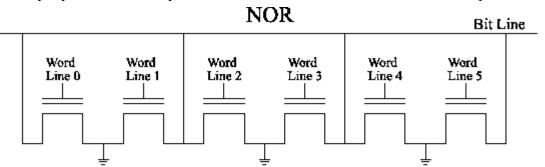
Cấu trúc phần tử nhớ flash có 2 loại là NAND và NOR

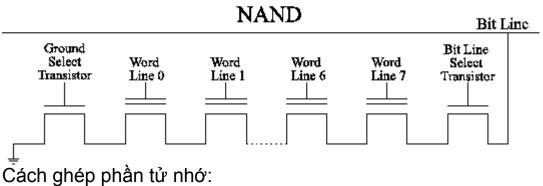
## Cấu trúc một phần tử nhớ flash:

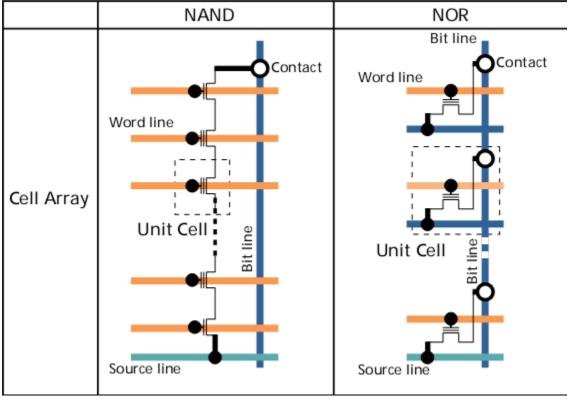
Trong bộ nhớ flash, mỗi phần tử nhớ giống như một MOSFET, ngoại trừ việc có thêm cực thả nổi (FG) cách ly xung quanh bởi một lớp oxit silic. các điện tử ở trong đó quyết định dữ liệu được ghi là 0 hay 1 và bị mắc kẹt ở đó. Như vậy cấu trúc này khá giống với cấu trúc ROM đã học.



Hai cách kết nối khác nhau dẫn đến hai loại cấu trúc NOR và NAND:







Tốc độ đọc ghi:

Hạn nộp:10/11/2013

25μs (first byte) và 0.025 μs	0.075 μs
với các byte sau	
26 MB/s (x8) or 41 MB/s	31 MB/s (x8) or
(x16	62 MB/s (x16)
$\approx 220 \mu s/2112$ bytes	128µs/32 bytes
7.5 MB/s	0.250 MB/s
128KB	128KB
500µs	1 sec
10 năm	10 năm
	với các byte sau 26 MB/s (x8) or 41 MB/s (x16 ≈ 220μs/2112 bytes  7.5 MB/s  128KB  500μs

## Tài liệu tham khảo:

 $\underline{http://dkc1.digikey.com/us/en/tod/Micron/NANDFlash\_NoAudio/NANDFlash\_NoAudio}.html$ 

http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/windbacher/node14.html

http://www.youtube.com/watch?v=s7JLXs5es7I